

2SA887

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形 / Si PNP Epitaxial Planar

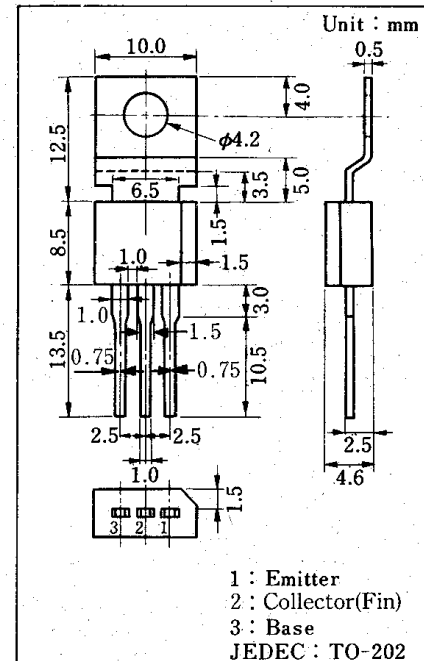
中出力電力増幅用 / Medium Power Amplifier
2SC1848 とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SC1848

■ 特 徴 / Feature

- 2SC1848 とコンプリメンタリペアで出力 7 W が得られます。
7 W output in complementary pair with 2SC1848.

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	-70	V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CE0}	-50	V
エミッタ・ベース電圧	V _{EB0}	-5	V
せん頭コレクタ電流	I _{CP}	-3	A
コレクタ電流	I _C	-2	A
コレクタ損失	P _C	1.2	W
		10	W
接合部温度	T _j	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55 ~ +150	°C



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Tc=25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I _{CBO}	V _{CB} = -40 V, I _E = 0			-1	μA
	I _{CEO}	V _{CE} = -20 V, I _B = 0			-100	μA
エミッタシャ断電流	I _{EBO}	V _{EB} = -5 V, I _C = 0			-10	μA
コレクタ・ベース電圧	V _{CB0}	I _C = -1 mA, I _E = 0	-70			V
コレクタ・エミッタ電圧	V _{CE0}	I _C = -10 mA, I _B = 0	-50			V
直流電流増幅率	h _{FE1} *	V _{CE} = -5 V, I _C = -1 A	50	130	220	
	h _{FE2}	V _{CE} = -5 V, I _C = -100 mA	30			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = -1 A, I _B = -0.1 A		-0.6	-1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	V _{BE(sat)}	I _C = -2 A, I _B = -0.2 A		-1.0	-1.5	V
トランジション周波数	f _T	V _{CB} = -5 V, I _E = 0.5 A		150		MHz

* h_{FE1} ランク分類 / h_{FE1} Classifications

Class	P	Q	R
h _{FE1}	50 ~ 100	80 ~ 160	120 ~ 220